

证书号第4313748号



# 发明专利证书

发明名称：一种基于  $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$  和  $\text{Al}_2\text{O}_3$  材料的 MOS 电容光敏器件及其制备方法

发明人：贾仁需；刘晶煌；李欢；庞体强；汪钰成；杜永琪

专利号：ZL 2019 1 0470603.0

专利申请日：2019年05月31日

专利权人：西安电子科技大学

地址：710071 陕西省西安市太白南路2号

授权公告日：2021年03月23日

授权公告号：CN 110350088 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页



证书号第 4313748 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 31 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

西安电子科技大学

发明人：

贾仁需；刘晶煌；李欢；庞体强；汪钰成；杜永琪